

Т. СУЛЕЙМЕНОВ, В. П. МАЛЫШЕВ, Н. С. БЕКТУРГАНОВ,  
А. З. ИСАГУЛОВ\*, К. Д. ТИШТИКБАЕВА\*, Ж. Н. АТАМБАЕВ\*, К. Т. БАЖИКОВ\*\*

## ТЕОРИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ В ОРБИТАЛЬНО-ОБОЛОЧЕЧНОМ ФУНКЦИОНАЛЕ ПЛОТНОСТИ

Известно, что многие концепции теорий аппроксимирующего квазичастичного функционала плотности [1] не учитывают анизотропию плотности распределения электронов в атомах и молекулах. В связи с этим представляет интерес учет этого эффекта с помощью теории возмущения. Целью настоящей работы является нахождение электронной плотности и энергии возмущенного атома, который находится в слабом внешнем поле. Кроме того, разработка концепции теории возмущения в методе атомов в молекуле (AM) позволила бы расширить возможности уже разработанной теории функционала плотности в аспекте ее практической реализации, как, например, с помощью пакета программ семейства GAUSSIAN [1], так как этот комплекс недостаточно хорошо описывает неорганические кластеры из-за ограниченных базисных функций. Данный аспект может быть преодолен с введением поправочных коэффициентов  $\lambda$ , величины которых не могут быть определены теорией возмущения.

Для оптимальной поправки предположим, что невозмущенная система представляет собой сферически симметричный атом, число электронов которого равно  $N$ , причем все они расставлены в оболочки, например  $N_{1s}, N_{2s}, \dots, N_{2n}$  и т.д. Если такой атом поместить в слабое внешнее электрическое поле  $V_s$ , то в результате воздействия этого поля изменяется распределение электронов, а также потенциал электронного облака.

Таким образом, электронная плотность при включении внешнего воздействия запишется

$$\rho' = \rho + \delta\rho.$$

Поскольку  $\rho$  представляет сумму плотностей в подоболочках, то

$$\rho = \sum_{i=1}^n \rho_i.$$

Следовательно, избыток плотности будет выглядеть как

$$\delta\rho = \sum_i \delta\rho_i.$$

Иными словами,

$$\rho' = \sum_i \rho_i + \sum_i \delta\rho_i$$

где  $\rho_i$  – плотность каждого слоя оболочки атомов.

Причем необходимо учесть, что

$$\int \sum_i \delta\rho_i = 0.$$

Так как число электронов при наличии возмущения не меняется, то

$$\int \rho'_e dv = \int \rho_e dv = N_e.$$

Потенциал электронного облака при наличии возмущения можно записать следующим образом:

$$\sum_i U'_e = \sum_i U_{ie} + \sum_i \delta U_{ie},$$

где  $\sum_i U_{ie}$  – потенциал невозмущенного электронного облака;  $\sum_i \delta U_{ie}$  – изменение потенциала электронного облака вследствие изменения плотности, т.е.

$$\sum_i \delta U_{ie}(U) = -e \int \frac{\sum_i \delta \rho_i(U')}{(U - U')} dV'.$$

Таким образом, в рамках теории функционала плотности Томаса–Ферми–Дирака для энергии возмущенного атома можно записать

$$E = \int \left[ x_k \rho^{5/3} - \left( U_k + \frac{1}{2} \sum_i U'_{ie} + V_s \right) e \rho' - \omega_c' \right] dv. \quad (1)$$

После проведения соответствующих преобразований (см. работу [2]) и с учетом изменения плотности для каждого слоя электронного облака  $\rho'$  можно заменить выражениями

$$\rho' = \sigma_0 \left( \sum_i U_i - \sum_i U_0 + V_s - V_0 \right)^{3/2}, \quad (2)$$

$$\rho' = \sigma_0 \left( \sum_i U_i - \sum_i U_0 \right)^{3/2} \times \\ \times \left( 1 + \frac{V_s - V_0}{\sum_i U_i - \sum_i U_{i0}} \right)^{3/2}. \quad (3)$$

Учитывая, что

$$U_s - U_0 \leq \sum_i U_i - \sum_i U_0,$$

можно разложить правую часть последнего выражения в ряд Тейлора и, пренебрегая членами разложения, получить для возмущенной плотности следующую формулу:

$$\rho' = \sum_i \rho_i \left( 1 + \frac{3(V_s - V_0)}{2(\sum_i U_i - \sum_i U_0)} \right), \quad (4)$$

где  $U_0$  – среднее значение возмущенного потенциала  $U_\rho$ . Отсюда

$$E' = \int \left[ x_k \rho'^{\frac{1}{3}} - \left( U_k + \frac{1}{2} \sum_i U'_{ie} + V_s \right) e \rho' - \omega'_c \right] dv. \quad (5)$$

После несложных преобразований для этого состояния энергии возмущения в первом и втором преобразованиях получим

$$\begin{aligned} \eta_1 &= e \int V_s \rho dv, \\ \eta_2 &= -U_s + U_p + U_k - U_a, \end{aligned} \quad (5^a)$$

где

$$\begin{aligned} U_s &= e \int V_s \delta \rho dv, \\ U_p &= -\frac{1}{2} e \int \sum_i \delta U_e \sum_i \delta \rho dv, \\ U_k &= \frac{5}{9} \delta e_k \int \frac{1}{\left( \sum_i \rho \right)^{\frac{1}{3}}} \left( \sum_i \delta \rho \right)^2 dv, \\ U_a &= \frac{1}{2} \int \frac{\delta^2 \omega}{\left( \sum_i \delta \rho \right)^2} \left( \sum_i \delta \rho \right)^2 dv. \end{aligned}$$

Для вычисления этих величин необходимо знать изменение плотности  $\sum_i \delta \rho_i$ .

Известно, что классическая модель атома дает для невозмущенной плотности следующее выражение:

$$\rho = \sigma_0 (U - U_0)^{\frac{3}{2}},$$

где  $U_0$  – множитель Лагранжа

То же можно записать и для возмущенного атома:

$$\rho' = \sigma_0 (U' + V_s - U'_0)^{\frac{3}{2}},$$

где  $U'_0$  – новый множитель Лагранжа, который равен

$$U'_0 = U_0 + V_0.$$

Вместе с тем

$$U = U_k + U'_e = U_k + U_e + \delta U_e.$$

Поскольку рассматривается изменение плотности для каждого слоя электронного облака, то

$$\rho' = \sigma_0 \left( \sum_i U_i - \sum_i U_0 + V_s - V_0 \right)^{\frac{3}{2}},$$

$$\rho' = \sigma_0 \left( \sum_i U_i^* - \sum_i U_0 \right)^{\frac{3}{2}} \left( 1 + \frac{V_s - V_0}{\sum_i U_i^* - \sum_i U_0} \right)^{\frac{3}{2}}.$$

Предположив, что  $V_s - V_0 \leq \sum U - \sum U_0$ , можно разложить в ряд правую часть этого уравнения:

$$\rho' = \sigma_0 \left( \sum_i U_i^* - \sum_i U_0 \right)^{\frac{3}{2}} \left( 1 + \frac{3(V_s - V_0)}{2(\sum_i U_i^* - \sum_i U_0)} \right), \quad (6)$$

$$\text{с учетом того, что } \sigma_0 \left( \sum_i U_i - \sum_i U_0 \right)^{\frac{3}{2}} = \sum_i \rho_i.$$

Предполагая бесконечно малое значение величины возмущения  $V_\xi$ , выражение (6) можно записать в виде

$$\rho' = \sum_i \rho \left( 1 + \frac{3(V_s - V_0)}{2(\sum_i U_i - \sum_i U_0)} \right). \quad (7)$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \sum \rho_i &= \frac{3(V_s - V_0)}{2(\sum_i U_i - \sum_i U_0)} \sum \rho = \\ &= \frac{9e}{10k} (V_s - V_0) \left( \sum_i \rho_i \right)^{\frac{1}{3}}, \end{aligned}$$

где

$$V_0 = \frac{\int V_s (\sum_i \rho_i)^{\frac{1}{3}} \delta v}{\int (\sum_i \rho_i^{\frac{1}{3}}) dv}.$$

Здесь  $V_0$  есть среднее значение возмущающего потенциала  $V_s$ .

Коэффициент, стоящий в левой части уравнений (6), (7) не дает точное описание возмущенной плотности, поэтому получение  $\rho'$  требует оптимизации. В связи с этим для  $\rho'$  применим следующее выражение:

$$\rho' = \sum_i \rho_i \left( 1 + \lambda \frac{V_s - V_0}{\sum U_i - \sum U_0} \right),$$

где  $\lambda$  – вариационный параметр.

Подставим это выражение в интеграл энергии (5<sup>a</sup>) и найдем условие минимума  $n_{12}$ , т.е.

$$\frac{d\eta_2}{d\lambda} = 0.$$

Тогда поправка для базисных функций  $\lambda_0$  имеет следующий вид:

$$\lambda_0 = \frac{W_s}{2(W_p + W_k + W_a)}.$$

Этот коэффициент является дополнением к экспонентам гауссовских функций в теории функционала плотности применительно к тяжелым атомам. Это позволяет расширить возможности пакета GAUSSIAN для расчета структуры кластеров, состоящих из базисных атомов.

Нами установлено соответствие такого подхода теореме Кона–Шема [3] для функционала плотности конденсированных сред.

Данный коэффициент возмущения может быть также использован для выяснения природы деформации внутренних оболочек атомов

вещества при образовании химической связи, а также при оценке ван-дер-ваальсова взаимодействия в кластерах.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Foresman J.B., Frisch. Exploring chemistry with electronic structure methods. Second Edition GAUSSIAN 98. Pittsburgh, P.A., 1998, P.298.
2. Hafner J. Effective enteramoiic forces and atomic and electronic structure of liquid and amorphous metals // 7. Phys. Condens. Mater. 1991. V. 136, N 1-2. P. 173-180.
3. Kohn W., Sham J. Self-consistent equations including Exchange and correlation effects // Phus. Rev. 1965. 140, A1133. P. 160-170.

## Резюме

GAUSSIAN бағдарламалық пакетіндегі гаусс функцияларының экспонентасына түзету енгізу жолы ұсынылған.

## Summary

In this work there has been offered a correction to the elements of gauss functions in the program complex GAUSSIAN.

УДК 539.182/184

ХМИ им. Ж. Абшиева, г. Караганда;

\*Карагандинский государственный технический университет,  
г. Караганда;

\*\* КазАТК, г. Актау

Поступила 27.04.06г.